2C12

多次元ネットワークを有するポルフィラジン誘導体薄膜の作製と電気化学

(名大物質国際研<sup>1</sup>、名大院理<sup>2</sup>) 藤縄祐<sup>1</sup>、鈴木陽介<sup>2</sup>、久保恵<sup>2</sup>、三吉康仁<sup>2</sup>、 吉川浩史<sup>2</sup>、阿波賀邦夫<sup>1</sup>

【序】フタロシアニン化合物(MPc)は大環状 共役 系を有しており、その構造や電気的、磁気的および光 学的性質に関して、基礎から応用まで様々な分野で幅 広く研究されてきた。その結晶や薄膜等の分子集合体 における構造的な特徴として、分子の 平面を重ね合 わせた一次元 スタック構造を形成するが、スタック 間では分子周縁部の水素原子によって分子間相互作



用が妨げられるということが知られている。本研究で用いたMTTDPz ( $M = H_2$ , Fe, Co, Ni, Cu, Zn; TTDPz = tetrakis(thiadiazole)porphyrazine)はMPc周縁部のベンゾ環をチアジアゾール環で置換した分子であり、チアジアゾール環のS<sup> $\delta+$ </sup>…N<sup> $\delta-$ </sup>に由来する強い分子間相互作用を有し、分子

集合体において多次元ネットワークを形成すること が期待される。我々はこれまでに、窒素気流下での減 圧昇華法により 8 種類の単結晶を得、結晶構造解析の 結果からそれらを 3 種類の結晶形(α-, β-, γ-form)に分 類できることが分かった(表1)<sup>1)</sup>。それらのうちα-form と呼ばれる結晶形は分子間のS...N接触により二次元 シート構造を形成していた(図1)。一方で、MTTDPz はチアジアゾール環導入による低いHOMO、LUMOエ ネルギーを示し、n型半導体として振舞うことが期待 される。そして溶液において可逆な一電子還元波が観 測される。

今回は、分子の集合状態として薄膜に着目し、各誘 導体の薄膜を作製した。とりわけα-form結晶を得るM = H<sub>2</sub>, Ni, Cuに関して、結晶状態における二次元シート 構造が薄膜に反映されることを期待した。得られた薄 膜について構造の評価を行い、電気化学特性を調べた。 表 1 MTTDPz 結晶の分類

$H_2$	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
α	β	β	α	α'	β
			γ	γ	



【実験】MTTDPzは既報の方法<sup>2)</sup>に従って合成した。薄膜は真空蒸着法により作製した。基板 として、Si(100)およびITOを用いた。蒸着前の到達真空度は~10<sup>-4</sup> Pa、蒸着速度を 0.6±0.2 Å/sec に調節し、約 100 nm蒸着した。作製した薄膜はDFM、XRDにより評価した。電気化学測定は、 薄膜を蒸着したITO基板を作用電極に、参照電極にAg/AgCl、対極にPt、0.1 mol dm<sup>-3</sup>の電解質 (NH<sub>4</sub>Cl, KCl, LiCl)水溶液を用い、室温で行った。 【結果と考察】図 2 にITO基板上に蒸着したH<sub>2</sub>TTDPz薄 膜のDFM像を示した。サブミクロンサイズのグレインが 密に積み重なり、比較的平滑な薄膜を形成している様子 が観察された。この特徴はSi(100)基板上の薄膜の場合と 同様であり、基板によらず良質の薄膜を得ることが出来 た。

各基板上に蒸着したH<sub>2</sub>TTDPz薄膜のXRD測定の結果 を図3に示す。どちらの場合も結晶において観測された  $\pi$ - $\pi$ スタッキング(0.33 nm)に対応するピーク(2 $\theta$  = 27.2°)が観測され、分子が基板に対して比較的平行に配 向していることが分かった。これはH<sub>2</sub>TTDPzにおいて、 分子間のS...N相互作用が薄膜作製の際に凝集力のひと つとして働いていることを示唆し、薄膜状態においても 二次元シート構造をとっていることを示唆している。

図4に電解質溶液として 0.1 mol dm<sup>-3</sup>のKCI水溶液を用 いたときのサイクリックボルタンメトリーの結果を示 す。酸化還元の波形は不可逆であり、特に 1 サイクル目 と 2 サイクル目以降とでかなり異なった挙動を示した。 しかしながら、薄膜の色変化は可逆であり(図 5)、数 サイクル後においても同様の色変化を観察することが



図 2 ITO 基板上に蒸着した H<sub>2</sub>TTDPz薄膜のDFM像



出来た。このように薄膜においても電気化学的に還元可 図3 H<sub>2</sub>TTDPz薄膜のXRDパターン 能であることが示唆されたが、色変化から二段階以上の過程が存在しているようである。つ まり、部分電荷移動状態が存在している可能性が考えられる。



現在、他の中心金属についても同様の実験を行っており、詳細については当日報告する。





0.3 V

2) P. A. Stuzhin et. al., Inorg. Chem., 1998, 37, 1533; E. M. Bauer et. al., Inorg. Chem., 1999, 38, 6114

<sup>1)</sup> Y. Suzuki et al., Chem. Eur. J., 2004, 10, 5158